

暫定規格

2SA714L PNPエピタキシャル型 シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

特長: 2SC1051Lとコンプリメンタリペアになります。

絶対最大定格/Ta=25°C

コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-100	volts
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	-80	volts
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6	volts
コレクタ電流	I _C	-7	A
せん頭コレクタ電流	i _{cp} ※※	-12	A
コレクタ損失	P _C Tc=25°C	60	W
保存周囲温度	T _{stg}	-40~+150	°C
接合部温度	T _j	150	°C

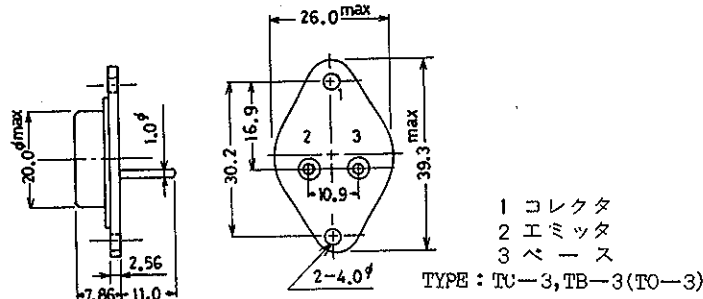
電気的特性/Ta=25°C

			min	typ	max	単位
C-E サステイン電圧	V _{CE0} (sus)	I _C =-50mA, I _B =0	-80			volts
C-B 降伏電圧	V _{(BR)CB0}	I _C =-5mA, I _E =0	-100			volts
コレクタしゅ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =-30V, I _E =0			-1	mA
エミッタしゅ断電流	I _{EB0}	V _{EB} =-6V, I _C =0			-5	mA
直流電流増幅率	h _{FE} ※	V _{CE} =-5V, I _C =-1A	※40		※320	
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =-5V, I _C =-1A		8		MHz
C-E 飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =-5A, I _B =-1A	-0.5		-1.5	volts
B-E 電圧	V _{BE}	V _{CE} =-5V, I _C =-1A	-0.75		-1.5	volts

※h_{FE} は次のように分類します。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形 (単位: mm)



※※ i_{cp} とはコレクタ電流の平均値が I_C(=7A) を超えない範囲で連続交流電流のピーク値の最大値を示す。

これらの仕様は 改良などのため予告なく変更することがあります。